

Балаковский инженерно-технологический институт – филиал федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Факультет атомной энергетики и технологий
Кафедра «Атомная энергетика»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине «Физические основы электронной техники»

Направление подготовки

«27.03.04 Управление в технических системах»

Основная профессиональная образовательная программа

«Управление и информатика в технических системах»

Квалификация выпускника

Бакалавр

Форма обучения

Очная

Цель освоения учебной дисциплины

Изучение физических явлений и процессов, лежащих в основе работы современных электронных приборов различного типа и назначений, предназначенных для построения информационно-управляющих систем и средств автоматизации.

Задачи изучения дисциплины:

- изучение физических принципов работы электронных и полупроводниковых приборов, их классификация, характеристики, область применения;
- изучение принципов построения электронных схем на основе рассматриваемых приборов соответствующего типа;
- освоение типовых методов расчета параметров и характерных существующих электронных приборов и схем по их основе.

Место дисциплины в структуре ООП ВПО

Дисциплина «Физические основы электронной техники» является дисциплиной вариативной части профессионального модуля учебного плана, составленного в соответствии с образовательным стандартом по направлению подготовки 27.03.04 «Управление в технических системах» (профиль «Управление и информатика в технических системах») и изучается студентами в третьем семестре.

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо студентам для изучения курса «Физические основы электронной техники» составляют дисциплины математического и естественнонаучного модуля – «Математика», «Физика», «Информатика», «Компьютерная графика». В частности, для изучения дисциплины необходимо общее знакомство с цепями постоянного и переменного тока, с законами Ома, Фарадея и Джоуля, с законом сохранения энергии и понятиями интеграла, производной и комплексного числа. Из вузовского курса физики необходимо знание разделов: «Электричество и магнетизм», «Электростатика и магнитостатика в вакууме и веществе», «Электрический ток», «Уравнения Максвелла», «Электромагнитное поле». Из курса высшей математики необходимо знание разделов: «Линейная алгебра», «Дифференциальное и интегральное исчисления», «Дифференциальные уравнения», «Теория функций комплексного переменного», «Последовательности и ряды», «Гармонический анализ», «Преобразования Лапласа».

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной для курсов: «Электротехника», «Электроника», «Теория автоматического управления», «Цифровые системы управления», «Робототехнические системы и комплексы» и др.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В процессе освоения данной дисциплины у студента формируется следующие компетенции:

Универсальные

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
УК-1	Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения по-	З-УК-1 Знать: методики сбора и обработки информации; актуальные российские и зарубежные источники информации в сфере профессиональной деятельности; метод системного анализа У-УК-1 Уметь: применять методики поиска, сбора и обработки информации; осуществлять критический анализ и

	ставленных задач	синтез информации, полученной из разных источников В-УК-1 Владеть: методами поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации; методикой системного подхода для решения поставленных задач.
--	------------------	---

Общепрофессиональные

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
ОПК-2	способен формулировать задачи профессиональной деятельности на основе знаний, профильных разделов математических и естественно-научных дисциплин (модулей)	З-ОПК-2 Знать: основные принципы и методы построения (формализации) и исследования математических моделей систем управления, их формы представления и преобразования для целей управления У-ОПК-2 Уметь: демонстрировать навыки использования знаний физики и математики для решения задач теоретического и прикладного характера В-ОПК-2 Владеть: аналитическими и числовыми методами для расчета технических параметров систем
ОПК-9	способен выполнять эксперименты по заданным методикам и обрабатывать результаты с применением современных информационных технологий и технических средств	З-ОПК-9 Знать: фундаментальные законы природы, а также физики и математики У-ОПК-9 Уметь: самостоятельно проводить экспериментальные исследования В-ОПК-9 Владеть: методиками обработки результатов с применением современных информационных технологий и технических средств

Задачи воспитания, реализуемые в рамках освоения дисциплины

Направление/цели	Создание условий, обеспечивающих	Использование воспитательного потенциала учебной дисциплины	Вовлечение в разнотипную внеучебную деятельность
Профессиональное и трудовое воспитание	- формирование культуры исследовательской и инженерной деятельности (В16)	Использование воспитательного потенциала дисциплин профессионального модуля для формирования инженерного мышления и инженерной культуры за счёт практических студенческих исследований современных производственных систем; проектной деятельности студентов по разработке и оптимизации технологических систем, связанной с решением реальных производственных задач; прохождения через разнообразные игровые, творческие, фестивальные формы, требующие анализа сложного объекта,	1. Организация научно-практических конференций и встреч с ведущими специалистами предприятий города и ветеранами атомной отрасли. 2. Организация и проведение предметных олимпиад и участие в конкурсах профессионального мастерства. 3. Участие в ежегодных акциях студенческих строительных

		постановки относительно него преобразовательных задач для их оптимального решения.	ных отрядов
--	--	--	-------------

Структура и содержание учебной дисциплины

Дисциплина преподается студентам в 3-ем семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ак. часов.

Календарный план

№ Р а з д е л а	№ Т е м ы	Наименование разде- ла (темы) дисципли- ны	Виды учебной деятельно- сти (в часах)					Аттестация раздела (форма*)	Макси- мальный балл за раздел**	
			Всего	Лекции	Лабораторные	Практические	СРС			
5 семестр										
1	1 раздел Основы зонной теории									
	1	Основы электронной теории материи	12	2/2	4/4	-	6	Т1 Т2	25	
	2	Приборы и устройства вакуумной электрони- ки	12	2	4	-	6			
	3	Приборы ионно- плазменной электро- ники	12	2	4/2		6			
2	2 раздел Свойства полупроводников									
	4	Электрофизические свойства полупровод- ников	14	2/2	6/4	-	6	Т3	25	
	5	Контактные и поверхностные явления в полупроводниках	14	2/2	6		6			
	6	Оптические явления в полупроводниках	8	2			6			
	7	Полупроводниковые приборы пассивного типа	10	2			8			
8	Усилительно- преобразующие при- боры)	26	2	8		16				
Вид промежуточной аттестации			108	16/6	32/10	-	60	3	50	

* - сокращенное наименование формы контроля

** - сумма максимальных баллов должна быть равна 100 за семестр, включая зачет и (или) экзамен

Сокращенное наименование форм текущего контроля и аттестации разделов:

Обозначение	Полное наименование
Т	Тестирование
З	Зачет

Содержание лекционного курса

Тема лекции. Вопросы, отрабатываемые на лекции	Всего часов	Учебно-методическое обеспечение
Лекция 1 Основы электронной теории материи. 1 Введение: Вещество и поле - формы существования материи. 2 Строение атомов и молекул с точки зрения электронной теории. 3 Работа выхода электронов, 4 Электронная эмиссия, эмиссионная электроника, 5 Движение электронов в электрических и магнитных полях 6 Электрический ток в вакууме, газах, жидких средах.	2	1-12
Лекция 2 Приборы и устройства вакуумной электроники. 1 Классификация электровакуумных приборов. 2 Электронные машины: диод, триод, лампы. 3 Приборы СВЧ: клистрон, приборы с длительным взаимодействием О- типа (ЛБВ, ЛОВ) и М - типа (магнетроны). 4 Электронно- лучевые приборы: (кинескоп, иконоскоп, осциллоскоп) 5 Фотоэлектронные приборы (фотоэлементы, ФЭУ).	2	1-12
Лекция 3 Приборы ионно-плазменной электроники. 1 Электрический разряд в газах, плазма и физические процессы в ней. 2 Ионные (газоразрядные) приборы.	2	1-12
Лекция 4 Электрофизические свойства твердых тел. 1 Основы зонной теории вещества. 2 Классификация веществ по электропроводности с точки зрения зонной теории. 3 Полупроводники и их внутренняя структура. 4 Носители заряда в полупроводниках. 5 Собственная и примесная проводимость полупроводников, её зависимость от температуры. 6 Дрейфовый и диффузионный токи в полупроводниках.	2	1-12
Лекция 5 Контактные и поверхностные явления в полупроводниках. 1 Барьеры на границе кристалла. 2 Электронно-дырочные р-п переходы. 3 Свойства р-п перехода при наличии внешнего напряжения, ВАХ р-п перехода.	2	1-12
Лекция 6 Оптические и фотоэлектрические явления в полупроводниках. 1 Фотопроводимость полупроводников. 2 Фоторезистивный эффект. 3 Фотоэффект в р-п переходе. 4 Электромагнитное излучение в полупроводниках.	2	1-12
Лекция 7 Полупроводниковые приборы пассивного типа. 1 Полупроводниковые резисторы (термо- и фоторезисторы, ва-	2	1-12

ристоры). 2 Полупроводниковые диоды: туннельные диоды, фото- и светодиоды, стабилитроны, ВЧ- и импульсные диоды.		
Лекция 8 Усилительно-преобразовательные приборы. 1 Устройство и принцип действия биполярных транзисторов. 2 Устройство и принцип действия полевых транзисторов	2	1-12
Всего	16	

Перечень практических занятий не предусмотрены учебным планом

Перечень лабораторных работ

Наименование лабораторной работы. Задания, вопросы, отрабатываемые на лабораторном занятии	Всего часов	Учебно-методическое обеспечение
<u>Определение удельного заряда электрона.</u> Формы существования материи. Электронная теория строения вещества. Основы зонной теории твердых тел. Работа выходов электронов, электронная эмиссия.	4	1-12
<u>Моделирование движений электрических зарядов в электрических и магнитных полях.</u> Электрический ток в различных средах. Принципы работы электровакуумных приборов, виды электровакуумных приборов. Электронно-лучевые и фотоэлектронные приборы. Газоразрядные и ионно-плазменные приборы. Электрофизические свойства полупроводников, типы проводимости и носители заряда в полупроводниках	8	1-12
<u>Изучение температурной зависимости удельной электропроводности полупроводников и металлов.</u> Определение ширины ΔE запрещенной зоны полупроводников	6	1-12
<u>Исследование термо-ЭДС при контакте металлов и полупроводников.</u>	6	1-12
<u>Изучение работы автогенератора на полупроводниковом транзисторе.</u> Валентность примесей. Механические и электрические свойства полупроводников. Физические характеристики полупроводников. Энергетические зоны электронов в полупроводнике. Зона проводимости и валентная зона полупроводника. Носители электрического тока собственного полупроводника. Легирование собственных полупроводников	4	1-12
<u>Изучение работы полевого транзистора.</u> Статические и динамические характеристики транзисторов. Усилительные свойства транзистора, температурные и частотные свойства транзистора. Полевые транзисторы, принцип действия и основные характеристики.	4	1-12
Всего	32	

Задания для самостоятельной работы студентов

Задания, вопросы, для самостоятельного изучения (задания))	Всего часов	Учебно-методическое обеспечение
Основы зонной теории вещества	6	1-12
Приборы вакуумной электроники	6	1-12
Приборы ионно-плазменного типа	6	1-12
Электрические свойства полупроводников. Электропроводность полупроводников в электрических полях. Эффект Ганна. Полупроводники в магнитном поле. Эффект Холла.	6	1-12
Свойства р-п перехода его ВАХ. Температурные и частотные свойства р-п перехода. Туннельный эффект. Гетеропереход: контакт металл-полупроводник, переход Шоттки.	6	1-12
Фотопроводимость полупроводников	6	1-12
Полупроводниковые элементы схем	8	1-12
Транзисторы и их применение. Схемы включения транзисторов. Статические и динамические характеристики транзистора. Усиленные свойства транзисторов. Транзистор как активный четырёхполюсник. Температурные и частотные свойства транзистора. Резистивный и резонансный усилители. Обратная связь в усилителях. Операционный усилитель. Полевые транзисторы. Однопереходной транзистор (двухбазовый диод). Фототранзисторы. Четырёхслойные полупроводниковые приборы (тиристоры).	16	1-12
Всего	60	

Расчетно-графическая работа

не предусмотрена учебным планом

Курсовая работа

не предусмотрена учебным планом

Курсовой проект

не предусмотрен учебным планом

Образовательные технологии

При реализации учебного материала курса используются различные образовательные технологии, такие как:

- 1) разбор конкретных ситуаций при решении задач по практическим заданиям;
- 2) разбор конкретных ситуаций при проведении лекционных занятий;
- 3) внеаудиторную работу в рамках текущих внеаудиторных консультаций с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

Целью при этом является выработка у студентов навыков и компетенций, позволяющих самостоятельно вести исследовательскую работу.

Лекции проводятся с использованием мультимедийного оборудования.

Лабораторные работы проводятся в форме проектных работ, как вида интерактивного обучения, выполняемых по индивидуальным заданиям.

Самостоятельная работа студентов проводится под руководством преподавателей, с оказанием консультаций и помощи при подготовке к контрольным работам, выполнении домашних заданий.

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Физические основы электронной техники»:

1) самостоятельная работа студентов с использованием информационной справочной системы ИОС;

2) активная работа с современными пакетами прикладных программ для обработки результатов экспериментальных данных.

Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств по дисциплине обеспечивает проверку освоения планируемых результатов обучения (компетенций и их индикаторов) посредством мероприятий текущего, рубежного и промежуточного контроля по дисциплине.

Связь между формируемыми компетенциями и формами контроля их освоения представлена в следующей таблице:

№ п/п	Наименование контролируемых разделов (темы)	Код и наименование индикатора достижения компетенций	Наименование оценочного средства
Входной контроль			
1	Входной контроль		Вопросы входного контроля (письменно)
Аттестация разделов, текущий контроль успеваемости			
2	Раздел 1. Основы зонной теории Тема 1. Основы электронной теории материи Тема 2. Приборы и устройства вакуумной электроники Тема 3. Приборы ионно-плазменной электроники	3-УК-1, У-УК-1, В-УК-1, 3-ОПК-2, У-ОПК-2, В-ОПК-2, 3-ОПК-9, У-ОПК-9, В-ОПК-9	T1,T2
3	Раздел 2. Свойства полупроводников. Тема 4. Электрофизические свойства полупроводников Тема 5. Контактные и поверхностные явления в полупроводниках Тема 6. Оптические явления в полупро-	3-УК-1, У-УК-1, В-УК-1, 3-ОПК-2, У-ОПК-2, В-ОПК-2, 3-ОПК-9, У-ОПК-9, В-ОПК-9	T3

	водниках Тема 7. Полупроводниковые приборы пассивного типа Тема 8. Усилительно-преобразующие приборы)		
Промежуточная аттестация			
4	<i>Зачет</i>	3-УК-1, У-УК-1, В-УК-1, 3-ОПК-2, У-ОПК-2, В-ОПК-2, 3-ОПК-9, У-ОПК-9, В-ОПК-9	Вопросы к зачету (письменно)

Входной контроль предназначен для выявления пробелов в знаниях студентов и готовности их к получению новых знаний. Входной контроль по дисциплине предусматривает краткие ответы на 10 вопросов, проводится в письменной форме. На ответы дается 30 минут.

Перечень вопросов входного контроля

1. Что такое электрическое поле? Каковы его источники?
2. Что такое напряженность электрического поля?
3. Что такое потенциал электростатического поля?
4. Каково строение атомов и молекул?
5. Чем отличаются проводники от диэлектриков?
6. Что такое емкость?
7. Что такое электрический ток?
8. Какой закон выражает величину силы тока в электрической цепи?
9. Что такое магнитное поле и чем оно создается?
10. Какая сила действует на электрический заряд, движущийся в магнитном поле?

Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня усвоения знаний и формирования умений и навыков в течение семестра. Текущий контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных (аудиторных) занятий, проводимых по расписанию. Формами текущего контроля выступают опросы на лабораторных занятиях. Отчет по лабораторным работам может быть оценен от 3 до 5 баллов. Аттестация раздела по дисциплине проводится в рамках контрольных недель в форме контроля по итогам, минимальная положительная оценка за который подразумевает усвоение студентом необходимого минимума материала, относящегося к разделу дисциплины.

На этапе аттестации разделов применяется тестирование - система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. На выполнение теста отводится 40 минут.

Оценочные средства текущего контроля включают в себя: отчеты по лабораторным работам, а также выполнение тестов Т1-Т3.

Примерный перечень тестовых заданий:

Тест - 1 Основы зонной теории

1. Каковы современные представления о строении материи?
 - А) строение материи основано на законах классической физики
 - Б) материя состоит из атомов и молекул
 - В) материя состоит из веществ и физических полей различной природы
 - Г) материя состоит из энергии и информации

2. Что такое «вещество» и каковы его основные характеристики?

- А) Вещество – это твердая форма материи
- Б) Вещество – вид материи, состоящий из дискретных образований, имеющих массу покоя.
- В) Это форма агрегатного состояния материи
- Г) Это непроницаемая физическая среда

3. Что такое «поле»?

- А) одна из форм существования материи, включающая электромагнитные и гравитационные поля
- Б) сила притяжения между телами
- В) вид взаимодействия тел
- Г) невидимая форма материи

4. Что такое «электрическое поле»?

- А) способ взаимодействия заряженных тел
- Б) форма существования материи
- В) материальный носитель взаимодействия между электрическими зарядами
- Г) результат электризации тел

5. Поясните возникновение магнитных полей.

- А) создаются магнитными зарядами
- Б) создаются намагниченными телами
- В) это одна из форм электромагнитного поля, создаваемая движением электрических зарядов
- Г) форма взаимодействия электрических токов

6. Существуют ли в природе магнитные заряды?

- А) да.
- Б) нет
- В) существуют магнитные полюсы у постоянных магнитов
- Г) у проводников с токами существуют магнитные заряды

7. В чем заключается роль электрических зарядов в строении вещества?

- А) электрические заряды входят в состав атомов и молекул, образующих вещества
- Б) электрические заряды образуют электронную оболочку атомов вещества
- В) электрические заряды связывают атомы вещества в молекулы
- Г) электрические заряды являются причиной радиоактивного распада ядер

8. Что такое «электрический ток»?

- А) поток заряженной жидкости
- Б) упорядоченное движение электрических зарядов в любой среде
- В) движение электронов в проводнике
- Г) движение положительных зарядов

9. Может ли тепловое движение свободных зарядов в веществе быть причиной электрического тока?

- А) тепловое движение зарядов в веществе является причиной электрического тока
- Б) тепловое движение зарядов в веществе не может быть причиной электрического тока
- В) тепловое движение помогает движению электрических зарядов
- Г) тепловое движение ухудшает протекание электрического тока

10. Какие силы действуют на электрические заряды со стороны электрических и магнитных полей?

- А) на электрические заряды действует сила притяжения
- Б) на электрические заряды действует сила Кулона со стороны электрического поля и сила Лоренца со стороны магнитного поля
- В) на электрические заряды действует сила Лоренца со стороны электрического поля
- Г) на электрические заряды со стороны магнитного поля действует сила Кулона

Тест- 2 Приборы и устройства вакуумной электроники

1. Что такое вакуум с точки зрения современной физики?

- А) пустое пространство между телами
- Б) газ, давление которого ниже атмосферного
- В) состояние газа в сосуде, когда длина свободного пробега молекул сравнима с размерами сосуда
- Г) область пространства, в которой не наблюдается наличие материальных частиц и полей

2. Что такое «технический» вакуум?

- А) вакуум, создаваемый откачиванием воздуха насосом из баллона
- Б) состояние газа в замкнутом объеме при давлении в нем ниже атмосферного, полученное откачкой газа из этого объема
- В) состояние газа под давлением
- Г) пространство внутри электронной лампы

3. Какие приборов относятся к электровакуумным?

- А) лампы накаливания и кенотроны
- Б) электронные и ионные приборы
- В) тиристоры и транзисторы
- Г) триоды, пентоды, диоды

4. Что такое электронная лампа?

- А) устройство для получения световых волн
- Б) электровакуумный прибор, содержащий два и более электродов и предназначенный для преобразования электрических величин
- В) устройство для создания приемников и передатчиков радиосигналов
- Г) часть рентгеновского аппарата

5. Чем отличается вакуумный триод от вакуумного диода?

- А) тем, что вакуум в нем в три раза больше, чем в диоде
- Б) тем, что в триоде имеется три анода
- В) тем, что в триоде, кроме катода и анода имеется управляющая сетка
- Г) тем, что в диоде два электрода, а в триоде- четыре

6. Что такое «электронная эмиссия»?

- А) излучение света электронами
- Б) испускание электронов из катода
- В) поглощение электронов анодом
- Г) истощение материала катода в лампе

7. Какие приборы относятся к электронно-лучевым?

- А) кинескопы, телескопы, микроскопы
- Б) газоразрядные источники света и люминесцентные лампы
- В) кинескопы, осциллографы, иконографы
- Г) фотоэлементы, неоновые лампы, лазеры

8. Каков принцип работы электронно-лучевых трубок с электростатическим управлением (ЭЛТ ЭУ)?

- А) в электронно-лучевых трубках с электростатическим управлением электронный луч управляется током катода
- Б) в электронно-лучевых трубках с электростатическим управлением управление лучом производится напряжением между отклоняющими пластинами
- В) принцип работы электронно-лучевых трубок с электростатическим управлением основан на законе Кулона
- Г) работа электронно-лучевых трубок с электростатическим управлением основана на электронной эмиссии электронной пушки

9. В чем особенности работы ЭЛТ с магнитным управлением (ЭЛТ-М)?

- А) имеют такую же конструкцию, что и ЭЛТ с ЭУ
- Б) ЭЛТ-М снабжены постоянными магнитами вдоль трубки
- В) ЭЛТ-М имеют магнитную отклоняющую систему и магнитную фокусировку
- Г) ЭЛТ-М снабжены магнитными линзами

10. Каков принцип работы фотоэлектронных приборов (ФЕП)?

- А) работа ФЭП основана на внутреннем фотоэффекте
- Б) работа ФЭП основана на внешнем фотоэффекте
- В) работа ФЭП основана на законе Столетова
- Г) работа ФЭП основана на законе Эйнштейна

11. Как может происходить ионизация газов?

- А) в результате столкновения атомов и молекул
- Б) в результате столкновения электронов с атомами и молекулами
- В) при столкновении быстрых электронов с атомами или молекулами
- Г) в результате приложения электрического напряжения

12. Что такое газовый разряд?

- А) разряжение газа в сосуде
- Б) электрический разряд в газе
- В) происходит самостоятельно при подаче электрического напряжения
- Г) бывает самостоятельным и несамостоятельным

13. В чем сущность явления рекомбинации ионов?

- А) образование новых молекул газа из имеющихся молекул
- Б) соединение ионов противоположного знака в нейтральные атомы и молекулы
- В) столкновение ионов с нейтральными атомами
- Г) столкновение ионов друг с другом

14. Какой разряд называется несамостоятельным?

- А) возникает в результате электрического пробоя в газе
- Б) возникает при наличии дополнительных ионизирующих факторов
- В) возникает при понижении давления в газе
- Г) возникает под действием переменного тока

15. Какой разряд в газе называется самостоятельным?

- А) возникает в газе самостоятельно без внешних причин
- Б) возникает под действием электрического напряжения в отсутствии внешних источников ионизации
- В) возникает в результате электрического пробоя в газе
- Г) возникает под действием переменного тока

16. Что такое ударная ионизация?

- А) результат соударения атомов газа
- Б) образование ионов при столкновении атомов или молекул
- В) результат столкновения быстрых электронов с атомами или молекулами с образованием новых заряженных частиц
- Г) упругое соударение электронов

17. Что такое плазма?

- А) сильно ионизованный газ с избытком положительных ионов
- Б) сильно ионизованный газ с избытком отрицательных зарядов
- В) сильно ионизованный газ с нулевым пространственным зарядом
- Г) четвертое состояние вещества

18. Каково применение плазмы в электронике?

- А) для резки и сварки металлов
- Б) для преобразования тепловой энергии в электрическую
- В) в стабилитронах и индикаторных приборах
- Г) в МГД-генераторах и установках термоядерного синтеза

19. Какие приборы относятся к газоразрядным?

- А) неоновые лампы
- Б) тиратроны и магнитоскопы
- В) жидкокристаллические индикаторы
- Г) некоторые индикаторные и преобразовательные приборы

20. Какие ионные приборы плазменной электроники используются для обработки информации
- А) газотроны и тиратроны
 - Б) индикаторные газоразрядные панели и плазменные дисплеи
 - В) электрофорезные дисплеи
 - Г) электролюминесцентные дисплеи

Тест- 3 Свойства полупроводников

1. В чем сущность зонной теории твердых тел?
 - А) твердые тела имеют слоистую структуру
 - Б) это теория, объясняющая электропроводность твердых тел
 - В) теория, описывающая распределение электронов по уровням энергии в твердых телах
 - Г) это теория, объясняющая проводимость полупроводников
2. Какова электрическая структура атомов в кристалле?
 - А) атомы в кристаллах объединены в слои
 - Б) атомы в кристаллах не взаимодействуют между собой
 - В) атомы в кристаллах объединены ковалентными связями
 - Г) атомы в кристаллах находятся в ионизованном состоянии
3. Где располагаются валентные электроны в атомах кристаллов?
 - А) на внешней оболочке атома
 - Б) в свободной зоне
 - В) в запрещенной зоне
 - Г) заполняют уровни валентной зоны
4. Что представляют собой металлы с точки зрения зонной теории?
 - А) вещества кристаллической структуры
 - Б) твердые тела, ширина запрещенной зоны которых равна 0.
 - В) твердые тела, ширина запрещенной зоны которых менее 2 эВ
 - Г) твердые тела с бесконечно широкой запрещенной зоной
5. Чем отличаются диэлектрики по зонной теории от металлов?
 - А) тем, что не имеют запрещенной зоны
 - Б) представляют собой жидкие вещества
 - В) вещества, у которых ширина запрещенной зоны не менее 2 эВ
 - Г) твердые тела, ширина запрещенной зоны которых менее 2 эВ
6. Полупроводники с точки зрения зонной теории...
 - А) аморфные тела
 - Б) твердые тела с шириной запрещенной зоны менее 0
 - В) твердые тела с шириной запрещенной зоны более 0
 - Г) вещества с шириной запрещенной зоны не более 2 эВ
7. Что является носителем тока в полупроводниках?
 - А) ионы
 - Б) заряженные частицы
 - В) электроны
 - Г) электроны и «дырки»
8. Когда возникают «дырки» в полупроводниках?
 - А) при потере атомом вещества валентного электрона
 - Б) при химическом взаимодействии кристалла с кислотой
 - В) при нагревании
 - Г) под воздействием электрического поля
9. В чем особенность собственной проводимости полупроводника?
 - А) величина, обратная удельному сопротивлению
 - Б) обусловлена движением свободных ионов
 - В) обусловлена перемещением свободных электронов

Г) складывается из электронной и дырочной электропроводности при этом концентрации электронов и дырок равны

10. В чем особенность примесной проводимости?

А) складывается из собственных носителей заряда и носителей заряда примеси

Б) обусловлена носителями примеси

В) равна собственной проводимости

Г) проявляется при облучении полупроводника УФ-лучами

11. Что такое «доноры» в полупроводниках?

А) атомы полупроводника, участвующие в создании электропроводности

Б) атомы примеси, отдающие данному полупроводнику свои «дырки»

В) атомы примеси, отдающие полупроводнику свои валентные электроны

Г) атомы химической примеси

12. Что такое акцепторы в полупроводниках?

А) вещества, усиливающие проводимость полупроводника

Б) атомы примеси, нейтрализующие собственную электропроводность

В) атомы примеси, захватывающие валентные электроны атомов полупроводника

Г) атомы примеси, отдающие данному полупроводнику свои «дырки»

13. Как соотносятся собственная и примесная проводимости?

А) не зависят друг от друга

Б) в собственных полупроводниках примесная проводимость отсутствует

В) в примесных полупроводниках собственная проводимость отсутствует

Г) концентрация неосновных носителей в примесном полупроводнике уменьшается во столько раз, во сколько увеличивается концентрация основных носителей

14. Как зависит проводимость полупроводников от температуры?

А) не зависит

Б) растет с ростом температуры

В) падает с ростом температуры

Г) стремится к 0 при стремлении температуры к бесконечности

15. Что происходит в полупроводнике при приложении электрического поля?

А) возникает пробой полупроводника

Б) носители начинают участвовать в создании электрического тока

В) носители начинают двигаться хаотично

Г) носители производят ионизацию атомов примеси

16. В чем сущность эффекта Холла?

А) в возрастании тока через полупроводник за счет внешнего электрического поля

Б) в возрастании тока через полупроводник за счет внешнего магнитного поля

В) возникает поперечная разность потенциалов, если приложить магнитное поле, параллельное направлению тока в полупроводнике

Г) возникает поперечная разность потенциалов, если приложить магнитное поле перпендикулярно направлению тока в полупроводнике

17. Что такое p-n переход?

А) спай двух полупроводников

Б) контакт двух полупроводников, обладающий односторонней проводимостью

В) область на границе раздела двух полупроводников с разным типом проводимости

Г) электронно-дырочный переход между металлом и полупроводником

18. В чем особенность p-n перехода при прямом напряжении?

А) является запирающим

Б) обладает малым сопротивлением электрическому току

В) сопротивление p-n перехода равно 0

Г) возникает потенциальный барьер

19. В чем особенность p-n перехода при обратном напряжении?

А) происходит пробой p-n перехода

- Б) ток через р-п переход равен 0
- В) сопротивлении р-п перехода значительно больше, чем при прямом
- Г) происходит экстракция носителей заряда

20. Каковы свойства контакта «металл-полупроводник»?

- А) обладает выпрямляющими свойствами
- Б) обладает омическими характеристиками
- В) обладает высоким сопротивлением
- Г) свойства зависят от соотношения работ выхода электронов из металла и полупроводника

21. Что такое «контакты Шотки»?

- А) контакты разнородных полупроводников
- Б) контакты разнородных металлов
- В) омические контакты металлов с полупроводниками
- Г) выпрямляющий контакт между металлом и полупроводником

22. Что такое фотопроводимость полупроводников?

- А) дополнительная проводимость, обусловленная действием на полупроводник квантов света
- Б) проводимость, обусловленная рекомбинацией фотонов и электронов
- В) проводимость, обусловленная рекомбинацией фотонов и дырок
- Г) проводимость, вызванная внешним фотоэффектом

23. Как проявляется фотопроводимость в случае р-п перехода?

- А) в случае р-п перехода фотопроводимость снижает сопротивление р-п перехода
- Б) фотопроводимость увеличивает обратный ток р-п перехода
- В) фотопроводимость вызывает разрушение р-п перехода
- Г) фотопроводимость не влияет на характеристики р-п перехода

24. Как определить красную границу собственных полупроводников?

- А) по величине фототока при освещении красным светом
- Б) по величине энергии активации собственной проводимости
- В) по изменению сопротивления полупроводника
- Г) по величине обратного напряжения на р-п переходе

25. Как определить красную границу примесных полупроводников?

- А) по величине энергии ионизации примеси при внутреннем фотоэффекте
- Б) по величине темнового тока в полупроводнике
- В) по величине удельного сопротивления примесного полупроводника
- Г) по величине энергии активации собственного полупроводника

26. Что такое люминесценция твердых тел?

- А) свечение за счет внешнего источника энергии
- Б) свечение нагретых тел
- В) любое свечение тел, кроме теплового
- Г) свечение под действием радиоактивного излучения

27. Как возникает индуцированное излучение в веществе?

- А) за счет ионизации атомов газа
- Б) за счет явления электромагнитной индукции
- В) при столкновении фотонов с возбужденными атомами вещества
- Г) возникает в лазерах

28. Что такое варистор?

- А) переменное сопротивление
- Б) вакуумный резистор
- В) вид транзистора
- Г) полупроводниковый резистор с нелинейной ВАХ

29. Что такое термисторы?

- А) металлическое сопротивление, зависящее от температуры
- Б) устройство для измерения температуры
- В) полупроводниковый резистор, сопротивление которого сильно зависит от температуры

Г) устройство стабилизации температуры

30. Что такое позисторы?

А) резистор с положительным значением сопротивления

Б) терморезистор с положительным значением ТКС

В) подогреваемый резистор

Г) полупроводниковый резистор

31. На чем основана работа тензорезисторов?

А) на пьезоэффекте

Б) тензорезисторном эффекте

В) на температурной зависимости их сопротивления

Г) имеют нелинейную ВАХ

32. Особенности туннельных диодов, лавинно-пролетных диодов и диодов Ганна?

А) имеют нелинейную ВАХ

Б) обладают отрицательным дифференциальным сопротивлением на участке ВАХ

В) используются для получения постоянного тока

Г) служат для генерации ВЧ-колебаний

33. Каково устройство биполярного транзистора?

А) полупроводниковая пластина с тремя областями разной электропроводности

Б) полупроводниковый прибор с тремя электродами

В) прибор с тремя р-п переходами

Г) полупроводниковый трансформатор

34. Как достигается усиление сигнала в транзисторе?

А) за счет внутренней энергии транзистора

Б) за счет энергии сигнала

В) за счет энергии источника питания

Г) путем воздействия сигнала на базу транзистора

35. Каковы основные режимы работы транзисторов?

А) активный и пассивный

Б) активный, пассивный, смешанный

В) активный, отсечки, насыщения

Г) усилительный, генераторный, преобразовательный

36. Статические характеристики биполярных транзисторов...

А) описывают связи входных и выходных величин

Б) определяют зависимость входного тока от напряжения

В) определяют зависимость выходного тока от напряжения

Г) характеризуют величину обратной связи по напряжению

37. Влияет ли температура на выходные характеристики транзистора?

А) не влияет

Б) влияет

В) влияет на входные и на выходные характеристики транзистора

Г) влияет на обратный ток коллектора

38. Варикапы – это...

А) полупроводники с переменной электропроводностью

Б) переменное полупроводниковое сопротивление

В) полупроводниковые диоды с переменной емкостью р-п перехода

Г) переменные конденсаторы

39. Как изменяется усиление транзистора с повышением частоты?

А) уменьшается

Б) не зависит от частоты

В) увеличивается

Г) происходит сдвиг фазы сигнала на выходе

40. В чем специфика импульсного режима работы транзистора?

- А) характеризуется режимом отсечки
- Б) характеризуется режимом насыщения
- В) представляет собой ключевой режим работы транзистора
- Г) характеризуется явлением запаздывания и искажением сигнала

41. Чем отличаются резистивный и резонансный усилители?

- А) резистивный и резонансный усилители - синонимы
- Б) резистивный усиливает постоянный ток, а резонансный - переменный
- В) резистивный усилитель – широкополосный, а резонансный - узкополосный
- Г) отличаются величиной обратной связи

42. Что такое обратная связь?

- А) Это влияние выходного сигнала на входной сигнал
- Б) Это передача части энергии выходного сигнала на вход усилителя
- В) Это изменение коэффициента усиления в процессе работы усилителя
- Г) Это коррекция частотных свойств усилителя за счет выбора режима его работы

43. Чем отличается положительная обратная связь от отрицательной обратной связи?

- А) знаком выходного сигнала
- Б) фазой подаваемого с выхода на вход по цепи обратной связи сигнала
- В) уровнем сигнала обратной связи
- Г) положительная обратная связь используется в усилителях, отрицательная обратная связь – в генераторах

44. Какой вид обратной связи используется в автогенераторных схемах?

- А) положительная обратная связь
- Б) отрицательная обратная связь
- В) положительная обратная связь и отрицательная обратная связь в зависимости от типа генератора
- Г) в генераторах обратная связь не используется.

45. Чем отличается последовательная ОС от параллельной?

- А) фазой сигнала
- Б) тем, что цепь обратной связи соединена в первом случае последовательно с источником сигнала, а во втором – параллельно.
- В) цепь обратной связи соединена параллельно входу
- Г) тем, что цепь обратной связи соединена последовательно выходу, а – параллельно входу усилителя.

46. Что представляет собой УПТ?

- А) Это усилитель переменного тока
- Б) это усилитель постоянного тока
- В) это усилитель медленно изменяющихся электрических сигналов
- Г) это операционный усилитель

47. В чем особенность работы полевых транзисторов?

- А) это особый вид транзистора
- Б) транзисторы, управляемые электрическим полем
- В) транзисторы, не содержащие базы
- Г) транзисторы, в которых выходной ток создается носителями только одного типа

48. Чем отличается однопереходный транзистор от полевого?

- А) однопереходный транзистор – разновидность полевого
- Б) в нем отсутствует управляемый канал
- В) отличается схемой включения
- Г) отличается рабочими характеристиками

49. Что представляет собой тиристор?

- А) Это транзистор с четырьмя выводами
- Б) Это транзистор с дополнительным р-п переходом, работающий в импульсном режиме
- В) это переключающий прибор, имеющий три р-п перехода, два из которых работают в прямом

направлении, а средний – в обратном

Г) это структура, состоящая из двух встроенных диодов

50. Что такое квантовая электроника?

А) это применение электроники в квантовой механике

Б) область электроники, основанная на использовании квантовых явлений

В) применение квантовой механики к электронике

Г) применение квантов света в электронике

51. Что такое активная среда?

А) вещество, атомы которого способны взаимодействовать с квантами света

Б) среда, атомы которой могут находиться в ионизованном состоянии

В) среда, атомы которой могут находиться в инверсном состоянии электронных энергетических уровней

Г) среда, служащая источником излучения света

52. В чем заключается процесс оптической накачки?

А) увеличение давления в сосуде, за счет внешнего фотоэффекта

Б) подвод энергии к источнику оптического излучения

В) подвод энергии к активной среде от источника оптического излучения

Г) генерация света оптическим квантовым генератором

53. Для чего нужен оптический резонатор?

А) для создания отрицательной обратной связи в активной среде оптического квантового генератора

Б) для создания положительной обратной связи в активной среде оптического квантового генератора

В) для оптической накачки активной среды оптического квантового генератора

Г) для размещения активной среды оптического квантового генератора

54. Что такое лазер?

А) квантовый усилитель света с положительной обратной связью

Б) квантовый усилитель света с отрицательной обратной связью

В) источник монохроматического излучения

Г) источник когерентных световых волн

55. Какие приборы называют оптоэлектронными?

А) работающие на основе фотоэффекта

Б) работающие на основе внутреннего фотоэффекта

В) работающие на основе внешнего фотоэффекта

Г) служащие для получения электрической энергии

56. Что такое оптроны?

А) простейшие оптоэлектронные устройства

Б) устройства для преобразования электрических сигналов в оптические

В) устройства, преобразующие оптическое излучение в электрический ток

Г) приборы, включающие источник и приемник излучения

Промежуточная аттестация – зачет проводится в форме письменной работы. Максимальный балл, который студент может получить на зачете – 50.

Перечень вопросов для подготовки к зачету:

1. Вещество и поле - формы существования материи.
2. Строение атомов и молекул с точки зрения электронной теории.
3. Работа выхода электронов,
4. Электронная эмиссия, эмиссионная электроника,
5. Движение электронов в электрических и магнитных полях
6. Электрический ток в вакууме, газах, жидких средах.
7. Классификация электровакуумных приборов.
8. Электронные машины: диод, триод, лампы.

9. Приборы СВЧ: клистрон, приборы с длительным взаимодействием О - типа (ЛБВ, ЛОВ) и М - типа (магнетроны).
10. Электронно- лучевые приборы: (кинескоп, иконоскоп, осциллоскоп)
11. Фотоэлектронные приборы (фотоэлементы, ФЭУ).
12. Электрический разряд в газах, плазма и физические процессы в ней.
13. Ионные (газоразрядные) приборы
14. Основы зонной теории вещества.
15. Классификация веществ по электропроводности с точки зрения зонной теории.
16. Полупроводники и их внутренняя структура.
17. Носители заряда в полупроводниках.
18. Собственная и примесная проводимость полупроводников, её зависимость от температуры.
19. Дрейфовый и диффузионный токи в полупроводниках.
20. Барьеры на границе кристалла.
21. Электронно-дырочные р-п переходы.
22. Свойства р-п перехода при наличии внешнего напряжения, ВАХ р-п перехода.
23. Фотопроводимость полупроводников.
24. Фоторезистивный эффект.
25. Фотоэффект в р-п переходе.
26. Электромагнитное излучение в полупроводниках.
27. Полупроводниковые резисторы (термо- и фоторезисторы, варисторы).
28. Туннельные диоды,
29. Фото- и светодиоды\
30. Стабилитроны,
31. ВЧ- и импульсные диоды.
32. Устройство и принцип действия биполярных транзисторов.

Студент, получивший менее 60% от максимального балла за раздел дисциплины или промежуточную аттестацию, считается неаттестованным по данной дисциплине.

В итоговую сумму баллов входят результаты аттестации разделов дисциплин и промежуточной аттестации. Итоговая оценка выставляется в двухбалльной системе путем перевода набранных баллов в соответствии со следующей таблицей:

Баллы (итоговой рейтинговой оценки)	Оценка (балл за ответ на зачете)	Требования к знаниям
100-60	«зачтено» 30 - 50 баллов	<ul style="list-style-type: none"> – Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он имеет знания основного материала, если он прочно усвоил программный материал, последовательно, четко и логически стройно его излагает его на зачете, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения, умеет тесно увязывать теорию с практикой – Учебные достижения в семестровый период и результатами рубежного контроля демонстрируют достаточную степень овладения программным материалом.
59-0	«не зачтено» 0 – 29 баллов	<ul style="list-style-type: none"> – Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки. Как правило, оценка «не зачтено» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

		– Учебные достижения в семестровый период и результатами рубежного контроля демонстрировали не высокую степень овладения программным материалом по минимальной планке.
--	--	--

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины

Основная литература:

- 1 Игнатов, А. Н. Оптоэлектроника и нанофотоника : учебное пособие / А. Н. Игнатов. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 596 с. <https://e.lanbook.com/reader/book/133479/#585>
- 2 Физические основы электроники и наноэлектроники: учебное пособие / И.М. Агеев. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 324 с. — URL: <https://e.lanbook.com/reader/book/131007/#1>
- 3 Немцов М.В. Электротехника и электроника: учебник / Немцов М.В. — М.: КноРус, 2020. — 560 с. — URL: <https://book.ru/book/934350>
- 4 Миловзоров О. В. Электроника: учебник / О. В. Миловзоров, Панков И. Г. ;рец. Мусолин А. К. - 5-е изд. — М.: ЮРАЙТ, 2013. - 407 с. — URL: <https://urait.ru/bcode/370268>

Дополнительная литература:

- 5 Гусев В.Г. Электроника и микропроцессорная техника: учебник / Гусев В.Г., Гусев Ю.М. — Москва: КноРус, 2020. — 798 с. — URL: <https://book.ru/book/934266>
- 6 Иванов И. И. Электротехника и основы электроники: учебник / И. И. Иванов, Г. И. Соловьев, В. Я. Фролов. — 8-е изд., стер. — СПб. : Лань, 2016. — 736 с. — URL: <https://e.lanbook.com/book/71749>
- 7 Белов Н. В. Электротехника и основы электроники: учебное пособие / Н. В. Белов, Ю. С. Волков. — СПб.: Лань, 2012. — 432 с. — URL: <https://e.lanbook.com/book/3553>
- 8 Новожилов О. П. Электротехника и электроника : учебник для бакалавров / О. П. Новожилов. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2019. — 653 с. — URL: <https://urait.ru/bcode/425261>

Методические указания

9. Знамцев Ю.М, Рогова М.В. Физические основы электронной техники. Методические указания к выполнению самостоятельной и контрольной работ по дисциплине «Физические основы электронной техники» для студентов направления подготовки 220400.62 «Управление в технических системах» всех форм обучения. -Балаково: БИТТУ, 2013. — 16 с.
10. Знамцев Ю.М, Рогова М.В. Изучение свойств полупроводникового р-п перехода. Методические указания к выполнению лабораторной работы по дисциплине «Физические основы электронной техники» для студентов направления подготовки 220400.62 «Управление в технических системах» всех форм обучения. -Балаково: БИТТУ, 2014. — 20 с.
11. Знамцев Ю.М, Рогова М.В. Исследование термо-эдс при контакте металлов и полупроводников. Методические указания к выполнению лабораторной работы по дисциплине «Физические основы электронной техники» для студентов направления подготовки 220400.62 «Управление в технических системах» всех форм обучения. -Балаково: БИТТУ, 2014. — 20 с.
12. Знамцев Ю.М, Рогова М.В. Исследование поведения полупроводника с током в магнитном поле. Изучение эффекта Холла. Методические указания к выполнению лабораторной работы по дисциплине «Физические основы электронной техники» для студентов направления 220400.62 «Управление в технических системах» всех форм обучения. -Балаково: БИТТУ, 2014. — 16 с.

Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины

В процессе освоения основной образовательной программы по дисциплине используются наглядные пособия, вычислительная техника (в том числе программное обеспечение) для показа презентаций, лабораторное оборудование.

Для самостоятельной работы студентов используется компьютерный класс с выходом в интернет.

Для изучения дисциплины используются электронные библиотеки:

- электронно-библиотечная система НИЯУ МИФИ (свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2012620735 от 01.08.2012 г.) без ограничения количества пользователей и без ограничения срока использования ресурсов;
- электронно-библиотечная система «Консультант студента» (общество с ограниченной ответственностью «Политехресурс»). Договор № 12-21-910 от 16.07.2021 г. на предоставление доступа к электронной библиотеке к комплектам «Медицина. Здравоохранение. Базовая коллекция», «Книги издательства «Феникс», «Издательский дом МЭМИ», «Книги издательства «Проспект»: «Иностранные языки»... по 31.08.2022 г.;
- электронно-библиотечная система «Айбукс» (договор № 09-21-910 от 02.07.2021 г.) на предоставление доступа по 31.08.2022 г.;
- электронно-библиотечная система «Лань» (договор № 10-21-910 от 16.07.2021 г. только на книги издательства «Лань») на предоставление доступа по 31.08.2022 г.;
- электронно-библиотечная система «Лань» (договор № 11-21-910 от 16.07.2021 г. на книги других издательств-партнёров издательства «Лань») на предоставление доступа по 31.08.2022 г.;
- электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» (договор № 13-21-910 от 30.08.2021 г.) на предоставление доступа по 31.08.2022 г.;
- электронно-библиотечная система «Консультант врача» (договор № 590KB/05-2021 от 01.06.2021 г.) на предоставление доступа по 06.08. 2022 г.;
- электронно-библиотечная система «BOOK.ru» (договор № 56 от 21.06.2021 г.) на предоставление доступа по 31.08.2022 г.;
- научная электронная библиотека «elibrary» (договор № SU-353/2022 от 14.12.2021 г.) на предоставление доступа по 31.12. 2022 г.
- международный онлайн ресурс ProQuest (договор № 19-21-910 от 18.10.2021 г.) на предоставление доступа по 30.11. 2022 г.

Учебно-методические рекомендации для студентов

1. Указания для прослушивания лекций

Перед началом занятий внимательно ознакомиться с учебным планом проведения лекций и списком рекомендованной литературы.

Перед посещением очередной лекции освежить в памяти основные концепции пройденного ранее материала. Подготовить при необходимости вопросы преподавателю. Не надо опасаться, что вопросы могут быть простыми.

На лекции основное внимание следует уделять не формулам и математическим выкладкам, а содержанию изучаемых вопросов, определениям и постановкам задач.

В процессе изучения лекционного курса необходимо по возможности часто возвращаться к основным понятиям и методам решения задач (здесь возможен выборочный контроль знаний студентов). Желательно использовать конспекты лекций, в которых используется принятая преподавателем система обозначений.

Для более подробного изучения курса следует работать с рекомендованными литературными источниками и вновь появляющимися источниками.

2. Указания для участия в лабораторных занятиях

Перед выполнением лабораторных работ необходимо пройти инструктаж по технике безопасности, ознакомиться с основными теоретическими сведениями, порядком выполнения работ и примером, обсудить с преподавателем основные моменты.

В процессе проведения эксперимента необходимо уточнять у преподавателя методику его проведения и правильность выполнения. По возможности самостоятельно доводить обработку экспериментальных данных до окончательного итога.

В конце лабораторного занятия при необходимости выяснить у преподавателя неясные вопросы. Оформить результаты выполнения работы в виде письменного отчета, в котором отобразить название и цель работы, основные теоретические сведения, ход работы с описанием всех этапов методики эксперимента. В конце отчета необходимо изложить выводы.

Подготовить ответы на вопросы для самоконтроля.

3. Указания для выполнения самостоятельной работы

Самостоятельная работа студентов обычно складывается из нескольких составляющих:

- работа с текстами: учебниками, дополнительной литературой, в том числе материалами интернета, а также проработка конспектов лекций;
- написание докладов, рефератов;
- подготовка к лабораторным занятиям;
- подготовка к зачету непосредственно перед ним.

Таким образом, самостоятельная работа студентов является необходимым компонентом получения полноценного высшего образования.

Методические рекомендации для преподавателей

1. Указания для проведения лекций

На первой вводной лекции сделать общий обзор содержания курса и отметить новые методы и подходы к решению задач, рассматриваемых в курсе, довести до студентов требования кафедры, ответить на вопросы.

При подготовке к лекционным занятиям необходимо продумать план его проведения, содержание вступительной, основной и заключительной части лекции, ознакомиться с новинками учебной и методической литературы, публикациями периодической печати по теме лекционного занятия. Перед изложением текущего лекционного материала напомнить об основных итогах, достигнутых на предыдущих лекциях. С этой целью задать несколько вопросов аудитории и осуществить выборочный контроль знания студентов.

В ходе лекционного занятия преподаватель должен назвать тему, учебные вопросы, ознакомить студентов с перечнем основной и дополнительной литературы по теме занятия. Раскрывая содержание учебных вопросов, акцентировать внимание студентов на основных категориях, явлениях и процессах, особенностях их протекания. Раскрывать сущность и содержание различных точек зрения и научных подходов к объяснению тех или иных явлений и процессов.

Следует аргументировано обосновать собственную позицию по спорным теоретическим вопросам. Приводить примеры. Задавать по ходу изложения лекционного материала риторические вопросы и самому давать на них ответ. Это способствует активизации мыслительной деятельности студентов, повышению их внимания и интереса к материалу лекции, ее содержанию. Преподаватель должен руководить работой студентов по конспектированию лекционного материала, подчеркивать необходимость отражения в конспектах основных положений изучаемой темы, особо выделяя, категориальный аппарат. В заключительной части лекции необходимо сформулировать общие выводы по теме, раскрывающие содержание всех вопросов, поставленных в лекции.

На последней лекции уделить время для обзора наиболее важных положений, рассмотренных в курсе.

2. Указания для проведения лабораторных занятий

Лабораторные занятия должны проводиться в специально оборудованных учебных лабораториях. Необходимыми структурными элементами лабораторной работы, помимо самостоятельной деятельности студентов, являются инструктаж, проводимый преподавателем, а также организация обсуждения итогов выполнения лабораторной работы.

Дидактические цели лабораторных занятий являются: овладение техникой эксперимента, формирование умений решать практические задачи путем постановки опыта, экспериментальное подтверждение изученных теоретических положений, экспериментальная проверка формул, расчетов.

Формируемые умения и навыки: наблюдать, сравнивать, сопоставлять, анализировать, делать выводы и обобщения, самостоятельно вести исследования, пользоваться различными приемами измерений, оформлять результат в виде таблиц, схем, графиков, получать профессиональные умения и навыки обращаться с различными приборами, аппаратурой, установками и другими техническими средствами при проведении опытов.

В процессе выполнения лабораторной работы следует постоянно контролировать работу студентов, не допуская их неправильных действий. Результаты выполнения лабораторной работы должны быть оформлены в виде отчета в Word.

3. Указания по контролю самостоятельной работы студентов

По усмотрению преподавателя задание на самостоятельную работу может быть индивидуальным или фронтальным.

При использовании индивидуальных заданий требовать от студента письменный отчет о проделанной работе.

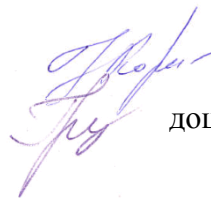
При применении фронтальных заданий вести коллективные обсуждения со студентами основных теоретических положений.

С целью контроля качества выполнения самостоятельной работы требовать индивидуальные отчеты (допустимо вместо письменного отчета применять индивидуальные контрольные вопросы).

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС НИЯУ МИФИ и учебным планом основной образовательной программы по направлению подготовки 27.03.04 Управление в технических системах

Рабочую программу составил доцент

Рецензент:



Корнилова Н. В.

доцент, Грицюк С.Н.

Программа одобрена на заседании УМКН 27.03.04 Управление в технических системах от 31.08.2021 года, протокол №1.

Председатель учебно-методической комиссии



Мefeldова Ю.А.